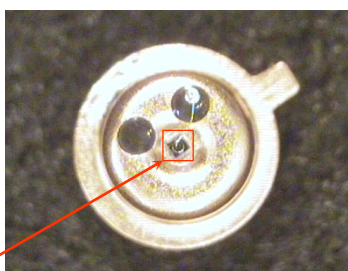
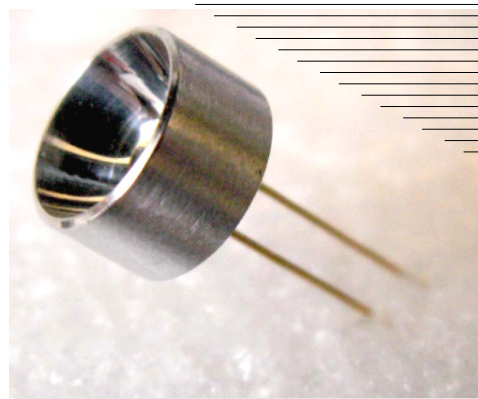


Особенности

- Высокая надёжность
- Высокая линейность
- Простота использования с модулями приёмник/усилитель
- Параболический отражатель



Фотодиодный ЧИП



Применение

- Измерительное оборудование
- ИК спектрофотометрия
- Лазерное детектирование
- Аналитические приборы

Опции

- Amplifier AM-07M

Общие сведения

Фотодиод **PD36-03-PR** применяется для детектирования излучения в среднем инфракрасном спектральном диапазоне от 1.5 мкм до 3.8 мкм при комнатной температуре.

Фотодиодный чип расположен на стандартном корпусе TO-18 с параболическим отражателем (PR).

Диаметр фоточувствительной площадки фотодиода **PD36-03-PR** 300 мкм. Высокая скорость фотоответа позволяет детектировать модулированное излучение лазерных диодов (LDs) и светодиодов (LEDs). **PR** позволяет увеличить D^* в 10 раз в случае нормального пучка излучения.

Дополнительно: фотодиод **PD36-03-PR** может быть использован в оптопаре с **LED18...LED36**.

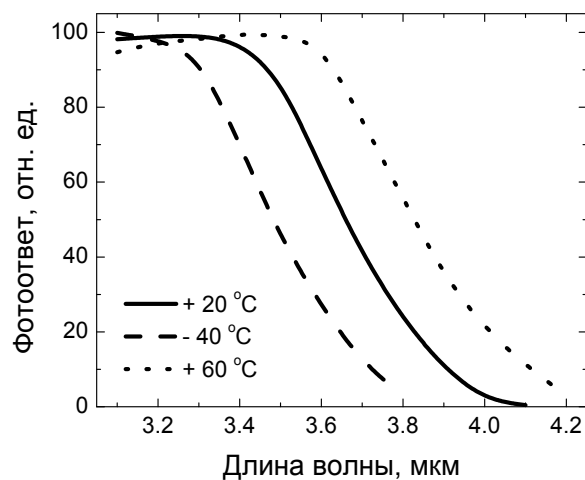
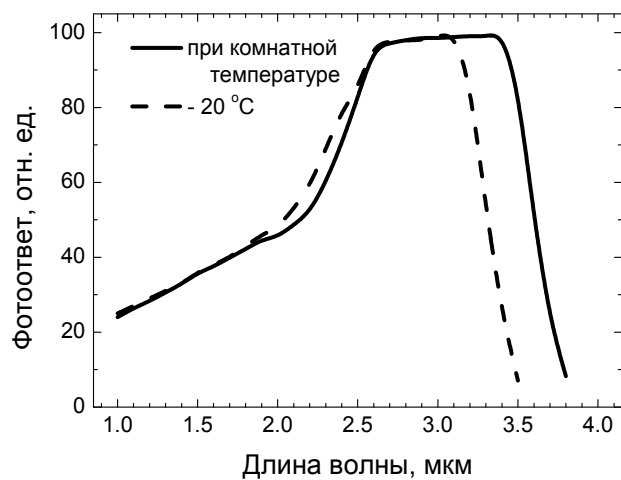
Основные данные

Корпус	Наименование параметра	Обозначение	Величина	Единица измерения
TO-18 с PR	Диаметр чувствительной площадки	d	0.3	мм
	Масса	m	0.65	г
	Рабочая температура	T _{opr}	- 200...+ 60	°C
	Температура припоя	T _s	+ 230	°C
	Температура хранения	T _{stg}	- 55...+ 70	°C
	Максимальное напряжение обратного смещения	V	- 1.0	В
	Габаритные размеры	D	9.0	мм
		H	18.5	

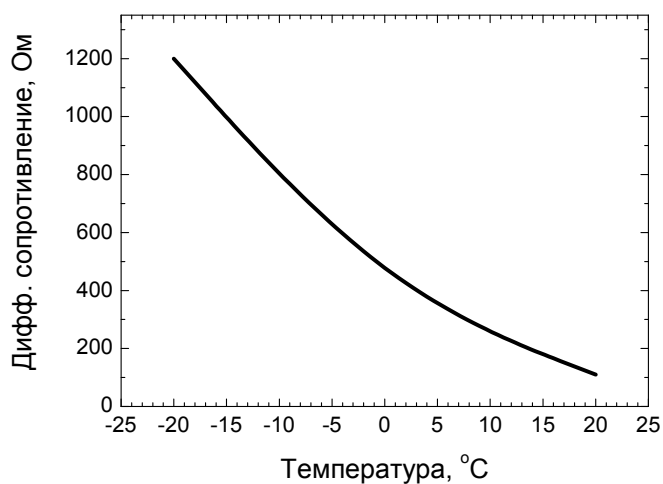
Электрические и фотоэлектрические параметры

Наименование параметра	Обозначение	Условие $T \approx +20^\circ\text{C}$	не менее	норма	не более	Единица измерения
Длинноволновая граница	λ	на уровне 10%	3.60	3.80	3.85	мкм
Спектральный диапазон	λ_p	на уровне 90%	2.55 - 3.45			мкм
Токовая монохроматическая чувствительность	S	при λ_p	1.0	1.1	1.2	А/Вт
Обнаружительная способность	D^*	при λ_p	$3 \cdot 10^9$	$4 \cdot 10^9$	$6 \cdot 10^9$	$\text{см} \cdot \text{Гц}^{1/2} \cdot \text{Вт}^{-1}$
Темновой ток	I_d	$V = -0.2 \text{ В}$	150	250	350	мкА
		$V = -0.4 \text{ В}$	200	400	500	
		$V = -0.6 \text{ В}$	300	600	800	
Электрическая ёмкость	C	$V = 0 \text{ В}$ $f = 1 \text{ МГц}$	100	400	1000	пФ
Время нарастания	t_r	$V = 0 \text{ В}, R_L = 50 \text{ Ом}$ $V = -0.5 \text{ В}$	20	10	120	нс
Время спада	t_f					
Дифференциальное сопротивление	R_0	$V \approx \pm 10 \text{ мВ}$	100	300	1200	Ом
Эквивалентная мощность шума	NEP	при λ_p	-	-	-	$\text{Вт} \cdot \text{Гц}^{-1/2}$

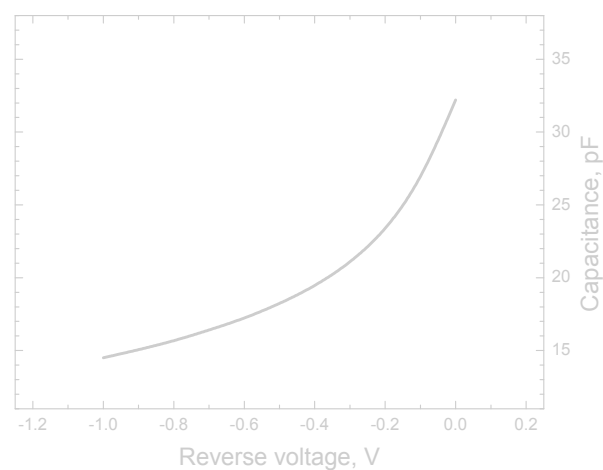
Спектр фоточувствительности



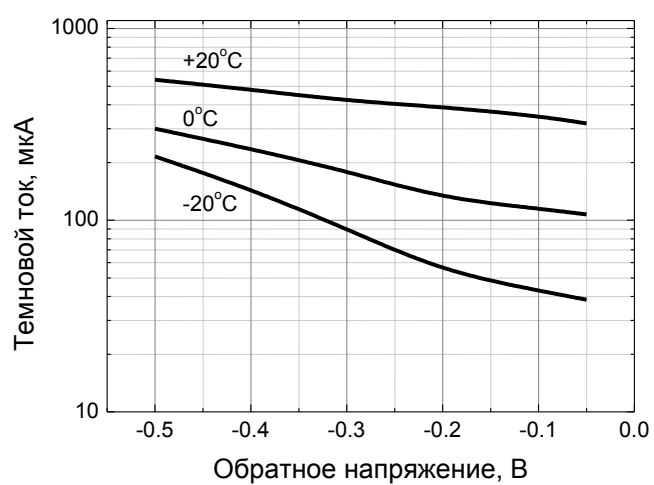
Дифференциальное сопротивление



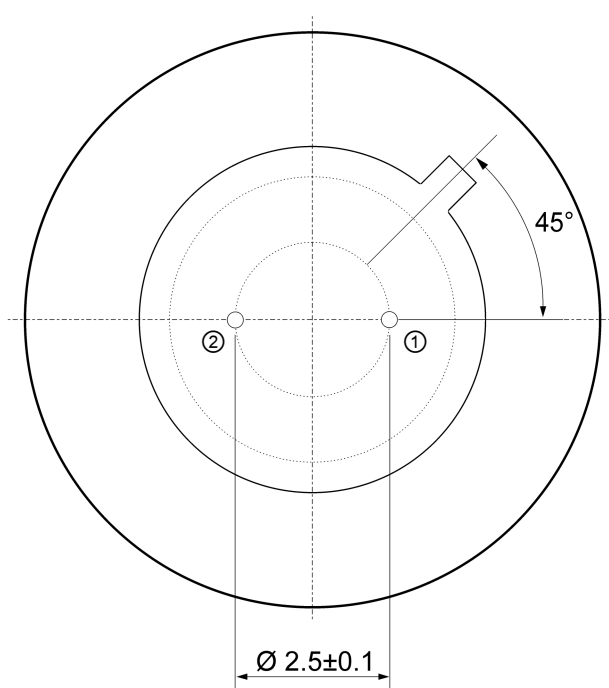
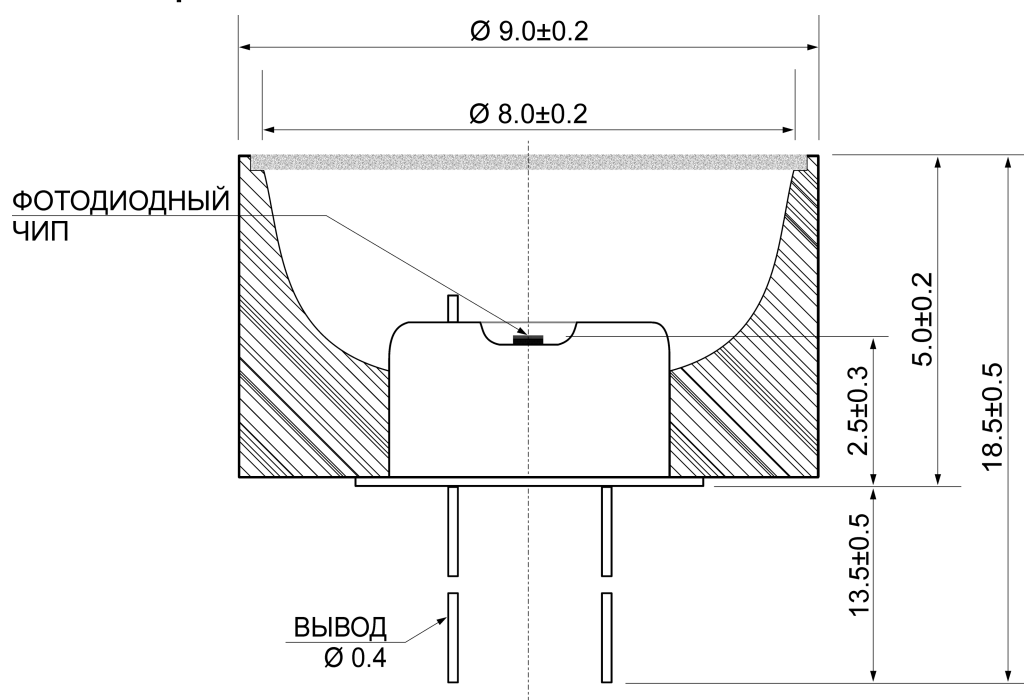
Электрическая ёмкость



Темновой ток



Размеры



Вывод	Описание
①	фотодиод (катод)*
②	фотодиод (анод)*

*По заказу полярность выводов может быть изменена.